



АЛФЬОРОВ Жорес Іванович (15. 03. 1930, м. Вітебськ, Білорусія — 01. 03. 2019, С.-Петербург) — фізик. Академік РАН (1979), іноз. чл. НАНУ (2000). Ленін. премія (1972), Державна премія СРСР, медаль Балантайна Інституту ім. Б. Франкліна (США), премія Хьюлета-Паккарда Європ. фіз. товариства, Нобелівська

премія з фізики (2000). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2003). Закін. Ленінгр. електротех. інститут (1952). Відтоді працював у Фіз.-тех. інституті РАН; від 1987 — директор цього інституту, а від 1990 — віцепрезидент РАН. Голова Президії С.-Петербур. наук. центру РАН. Дослідж. у галузі фізики напівпровідників, напівпровідникової і квант. електроніки, фізики і технології напівпровідник. приладів. З його участю створ. перші в СРСР транзистори і фотодіоди, потужні германієві діоди. А. розробив метод створення напівпровідник. гетероструктур, які відкрили шлях до керованого конструювання зонної структури твердих тіл. Цей метод привів до розробки першого покоління наноелектрон. приладів. 1999 А. став одним з ініціаторів формування рос.-укр. програми досліджень у галузі нанофізики і наноелектроніки.

Основні праці

Физика и жизнь. С.-Петербург, 2000.

Рекомендована література

1. Физики.

[Д. Т. Тарашенко](#)

Бібліографічний опис:

Алфьоров Жорес Іванович / Д. Т. Тарашенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. — Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-43858>. — Останнє поновлення : 2019.

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).